

Конкурс научно-исследовательских проектов Института перспективных технологий Самсунг (SAIT)

Московское Представительство компании Самсунг Электроникс информирует о конкурсе научно-исследовательских проектов Института перспективных технологий Самсунг (SAIT). Данный конкурс предполагает заключение научно-исследовательских контрактов с его победителями на сумму от 50000 до 100000 долл. США, включая накладные расходы.

Научные направления (включающие 32 конкретные темы):

1. Проактивные вычисления «в облаке»;
2. Спаренная передача электронов и протонов (PCET);
3. Фотонное интегральное соединение;
4. Инжиниринг метаболических процессов;
5. Органические солнечные элементы;
6. Информационные технологии будущего;
7. UX будущего поколения;
8. Однокристалльные системы (SOC);
9. Мехатроника;
10. Новые технологии памяти;
11. Архитектура системы;
12. Новые среды и вычисления;
13. Материалы и устройства;
14. Экология;
15. Медицинские технологии.

Срок: до 28 мая 2011 года.

Проектное предложение оформляется по форме (http://www.sait.samsung.com/eng/about/e_open_2011.jsp), объём — не более 10 страниц, включая любые приложения, плюс CV научного руководителя проекта, его коллеги и одного магистранта или аспиранта.

В СФУ обращаться:

Евгения Маркова,
начальник отдела международных проектов и программ
Центра грантовой поддержки
пр. Свободный, 82 А, ауд. 224-5
тел.: 249-79-12
E-mail: ELementa@sfu-kras.ru

- [SAMSUNG.doc](#) (.doc, 30 КБ)

Центр грантовой поддержки, 15 апреля 2011 г.

© Сибирский федеральный университет. Редакция сайта: +7 (391) 246-98-60, info@sfu-kras.ru.

Адрес страницы: <https://news.sfu-kras.ru/node/7912>